

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-222944

(P2001-222944A)

(43)公開日 平成13年8月17日(2001.8.17)

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

H 0 1 J 1/32

H 0 1 J 1/32

A 5 C 0 4 0

11/02

11/02

B

65/00

65/00

A

審査請求 未請求 請求項の数17 O L (全 13 頁)

(21)出願番号 特願2000-334120(P2000-334120)

(71)出願人 590002817

(22)出願日 平成12年11月1日(2000.11.1)

三星エスディアイ株式会社

(31)優先権主張番号 00-5648

大韓民国京畿道水原市八達區▲しん▼洞
575番地

(32)優先日 平成12年2月7日(2000.2.7)

(72)発明者 李 ▲浣▼泰

(33)優先権主張国 韓国 (K R)

大韓民国 京畿道 龍仁市 器興邑 農書
里 山14-1番地 三星綜合技術院内

(72)発明者 崔 原鳳

大韓民国 京畿道 龍仁市 器興邑 農書
里 山14-1番地 三星綜合技術院内

(74)代理人 100064414

弁理士 磯野 道造

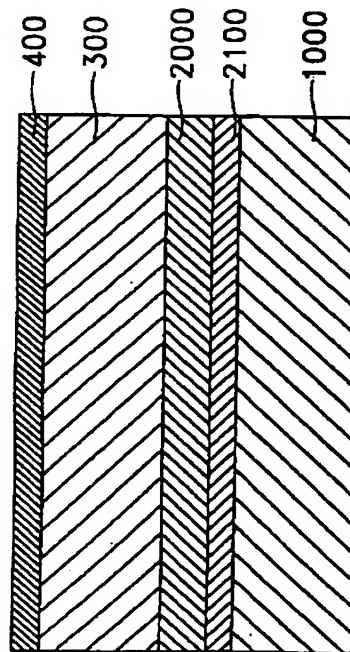
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 カーボンナノチューブを採用した2次電子増幅構造体及びこれを用いたプラズマ表示パネル及びバックライト

(57)【要約】

【課題】 カーボンナノチューブを採用した2次電子増幅構造体及びこれを用いたプラズマ表示パネル及びバックライトを提供する。

【解決手段】 本発明に係る2次電子増幅構造体は、カーボンナノチューブ上にMgO薄膜やMgF₂、CaF₂、及び、LiFのようなフッ化物やAl₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂及びLa₂O₃のような酸化物薄膜を積層した構造で製作されて、電子やイオンによる2次電子放出係数を増大させる作用をする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 カーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層された MgO 層とを具備したことを特徴とする 2 次電子増幅構造体。

【請求項 2】 前記 MgO 層の代りに MgF_2 、 CaF_2 、 LiF 、 Al_2O_3 、 ZnO 、 CaO 、 SrO 、 SiO_2 及び La_2O_3 中いずれか一つの物質よりなる層が形成されたことを特徴とする請求項 1 に記載の 2 次電子増幅構造体。

【請求項 3】 前記カーボンナノチューブは Cs、W、Mo、Ta、Fe、Cu 中少なくともいずれか一つの金属で形成された電極上に塗布されたことを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の 2 次電子増幅構造体。

【請求項 4】 一定の間隔を隔ててお互い対向するように配置された前面基板及び背面基板と、前記二つの基板の対向面上にお互い交差する方向にストライプ状で形成された電極と、前記背面基板上の電極間にこの電極と並んだ方向に形成され、前記前面基板と前記背面基板とが一定の間隔を維持するように支持すると同時に放電セルを形成する隔壁と、前記隔壁の側面及び背面基板の電極上に塗布された蛍光体とを具備したプラズマ表示パネルにおいて、前記前面基板の電極上に形成されたカーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層された MgO 層とを具備した 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネル。

【請求項 5】 前記 MgO 層の代りに MgF_2 、 CaF_2 、 LiF 、 Al_2O_3 、 ZnO 、 CaO 、 SrO 、 SiO_2 及び La_2O_3 中いずれか一つの物質よりなる層が形成されたことを特徴とする請求項 4 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネル。

【請求項 6】 前記電極が Cs、W、Mo、Ta、Fe、Cu 中の少なくともいずれか一つの金属で形成されたことを特徴とする請求項 4 または請求項 5 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネル。

【請求項 7】 前記蛍光体と背面基板の電極との間にカーボンナノチューブがさらに形成されたことを特徴とする請求項 4 または請求項 5 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネル。

【請求項 8】 前記蛍光体と前記 MgO 層との隔壁側面にカーボンナノチューブがさらに形成されたことを特徴とする請求項 4 または請求項 5 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネル。

【請求項 9】 一定の間隔を隔ててお互い対向するように配置された前面基板及び背面基板と、前記背面基板上にストライプ状に形成されたアドレス電極と、前記アドレス電極間の前記背面基板上に前記アドレス電

極と並んだ方向に形成されて、前記前面基板と前記背面基板とが一定の間隔を維持するように支持すると同時に放電セルを形成する隔壁と、

前記隔壁の側面及び前記アドレス電極上面に塗布された蛍光体と、

前記前面基板上に前記アドレス電極と交差する方向にストライプ状でお互い一定の間隔で並んで形成された走査電極及び共通電極と、

前記前面基板上に前記走査電極及び共通電極を覆うように積層された誘電体層とを具備したプラズマ表示パネルにおいて、

前記誘電体層上に形成されたカーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層された MgO 層とを具備した 2 次電子増幅構造体を採用した 3 電極面放電型プラズマ表示パネル。

【請求項 10】 前記 MgO 層の代りに、 MgF_2 、 CaF_2 、 LiF 、 Al_2O_3 、 ZnO 、 CaO 、 SrO 、 SiO_2 及び La_2O_3 中いずれか一つの物質よりなる層が形成されたことを特徴とする請求項 9 に記載の 3 電極面放電型プラズマ表示パネル。

【請求項 11】 前記電極が Cs、W、Mo、Ta、Fe、Cu 中の少なくともいずれか一つの金属で形成されたことを特徴とする請求項 9 または請求項 10 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用した 3 電極面放電型プラズマ表示パネル。

【請求項 12】 前記蛍光体と背面基板の電極との間にカーボンナノチューブがさらに形成されたことを特徴とする請求項 9 または請求項 10 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用した 3 電極面放電型プラズマ表示パネル。

【請求項 13】 前記蛍光体と前記 MgO 層との隔壁側面にカーボンナノチューブがさらに形成されたことを特徴とする請求項 9 または請求項 10 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用した 3 電極面放電型プラズマ表示パネル。

【請求項 14】 一定の間隔を隔ててお互い対向するように配置されて放電空間を形成する前面基板及び背面基板と、

前記前面基板内側面上に形成された初期放電用の第 1 電極と、

前記第 1 電極上に形成された蛍光体層と、

前記背面基板上の内側面に一定の間隔を隔ててお互い並んだ方向のストライプ状で形成された放電維持用の第 2 電極及び第 3 電極と、

前記背面基板上に前記第 2 電極及び第 3 電極を覆うように塗布された誘電体層と、

前記前面基板と背面基板とを一定の間隔をあけて維持しながら放電空間を密封する隔壁とを具備したバックライトにおいて、

前記誘電体層上に形成されたカーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層された MgO 層とを

具備したことを特徴とする 2 次電子増幅構造体を採用したバックライト。

【請求項 15】 前記 MgO 層の代りに、MgF₂、CaF₂、LiF、Al₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂ 及び La₂O₃ 中いずれか一つの物質よりなる層が形成されたことを特徴とする請求項 14 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用したバックライト。

【請求項 16】 前記第 2 電極及び第 3 電極は Cs、W、Mo、Ta、Fe、Cu 中少なくともいずれか一つの金属で形成されたことを特徴とする請求項 14 または 10 請求項 15 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用したバックライト。

【請求項 17】 前記蛍光体と第 1 電極との間にカーボンナノチューブがさらに形成されたことを特徴とする請求項 14 または請求項 15 に記載の 2 次電子増幅構造体を採用したバックライト。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明はカーボンナノチューブを採用した 2 次電子増幅構造体、及びこれを用いたプラズマ表示パネル、及びバックライトに関する。

【0002】

【従来の技術】 20 世紀情報革命手段中の一つのディスプレイは、大きくブラウン管と平面ディスプレイ素子とに分けられるが、既存のブラウン管に比べて平面ディスプレイ素子は薄くて携帯性が良いし、消費電力が低くて既存のブラウン管の短所を補完しながら新たな領域の市場を形成している。このような平面ディスプレイ素子としては LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)、PDP (PLASMA DISPLAY PANEL)、FED (FIELD EMISSION DISPLAY) などが主流をなし、その中で PDP は大画面に有利で LCD の短所を最大限補完できる。また、このような平面ディスプレイ素子の弱点を補完して輝度向上を図りうるものとして、光増倍器チューブ (photomultiplier tube; PMT) とマイクロチャンネル板 (microchannel plate; MCP) のような光増幅素子がある。

【0003】 図 1 は、現在代表的に使われている 3 電極面放電型プラズマ表示パネルの概略的な構造を示す斜視図で、図 2 (a) 及び図 2 (b) は、各々図 1 の 3 電極面放電型プラズマ表示パネルを横及び縦方向に切開した断面を示す垂直断面図である。

【0004】 図に示したように、3 電極面放電型プラズマ表示パネルは、所定の隙間を隔てて互いに向き合った、前面ガラス基板 20 と背面ガラス基板 10 から構成される。隔壁 13 はこの隙間の間を区分し、各画素に対応する放電空間 21 をもつセルを形成する。放電を行うすべてのセルには、アドレス電極 11、走査電極 14、共通電極 15 が含まれており、走査電極 14 と共通電極 15 はアドレス電極 11 と交差する方向の同一平面上に並んで配置されている。そして、面放電により画像を表

示する。ここで、部材番号 12 は誘電体層、部材番号 17 は蛍光体、部材番号 16 はバス電極、部材番号 18 は誘電体層、そして部材番号 19 は MgO 保護層である。

【0005】 このように、PDP は基板上に隔壁を形成してプラズマ放電空間 (セル) を作り、放電することによって映像を表示する。隔壁 13 は一般的な印刷法により均一のパターンを持つように形成される。そして、セル中での放電を、隣接セルの放電とは区別した形で行う。この中で PDP の放電セル内での MgO 保護層 19 の役割は、放電セル 21 内に 2 次電子を放出して効率を高めることによって、電極間に印加される放電電圧を下げられるようにし、パネル内部にある電極を保護することである。

【0006】 現在、PDP、FED、光増幅素子として用いられている物質は、2 次電子放出係数が低いために電子増幅率が低くて電圧増加と輝度弱化的原因になる。PDP では MgO が 2 次電子を放出する保護層として使われている。PDP は放電を用いた素子であるため、放電がよく発生できるような放電空間を有する放電セルが形成されるべきである。このような放電セルの空間内に、保護膜として MgO 層が形成されている。このような MgO 層の形成は、主にスパッタリング、電子ビーム蒸着法で薄膜を形成するが、このような MgO 単一物質の蒸着だけではプラズマ放電空間内で、十分な 2 次電子放出効果を奏するには限界がある。また、PMT や MCP のような光増幅素子及び FED でも同じように 2 次電子放出を極大化する必要がある。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、前記のような問題点を改善するために創案したものであって、2 次電子を放出する MgO 層の長所を最大限生かしながら、カーボンナノチューブを積層して、2 次電子放出を極大化できる 2 次電子増幅構造体を提供することにその目的がある。また、本発明は前記のような問題点を改善するために創案したものであって、前記のように 2 次電子放出を極大化して輝度を向上させたり、駆動電圧を下げられる 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネル、及び、液晶表示パネル用バックライトを提供することにその目的がある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 前記のような目的を達成するために、本発明に係る 2 次電子増幅構造体は、カーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層された MgO 層とを具備したことを特徴とする。本発明において、前記 MgO 層の代りに、MgF₂、CaF₂、LiF、Al₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂ 及び La₂O₃ 中いずれか一つの物質よりなる層が形成され、前記カーボンナノチューブは、Cs、W、Mo、Ta、Fe、Cu 中少なくともいずれか一つの金属で形成された電極上に塗布されたことが望ましい。

【0009】また、前記のような目的を達成するために、本発明に係る2次電子増幅構造体を採用した3電極面放電型プラズマ表示パネルは、一定の間隔を隔ててお互い対向するように配置された前面基板及び背面基板と、前記二つの基板の対向面上にお互い交差する方向のストライプ状で形成された電極と、前記背面基板上の電極間にこの電極と並んだ方向に形成されて、前記前面基板と前記一定の間隔を維持するように支持すると同時に放電セルを形成する隔壁と、前記隔壁の側面及び背面基板の電極上に塗布された蛍光体とを具備したプラズマ表示パネルにおいて、前記前面基板の電極上に形成されたカーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層されたMgO層とを具備した2次電子増幅構造体を採用したことを特徴とする。

【0010】本発明において、前記MgO層の代りに、 MgF_2 、 CaF_2 、 LiF 、 Al_2O_3 、 ZnO 、 CaO 、 SrO 、 SiO_2 及び La_2O_3 中いずれか一つの物質よりなる層であっても良く、前記電極はCs、W、Mo、Ta、Fe、Cu中少なくともいずれか一つの金属で形成されていることが好ましい。プラズマ表示パネルはまた、前記蛍光体と背面基板の電極との間にカーボンナノチューブを有する構成、および／または、前記蛍光体と前記MgO層との間の隔壁側面にカーボンナノチューブを有する構成である。

【0011】また、前記のような目的を達成するために、本発明に係る2次電子増幅構造体を採用した3電極面放電型プラズマ表示パネルは、一定の間隔を隔ててお互い対向するように配置された前面基板及び背面基板と、前記背面基板上にストライプ状で形成されたアドレス電極と、前記アドレス電極間の前記背面基板上に前記アドレス電極と並んだ方向に形成されて、前記前面基板との前記一定の間隔を維持するように支持すると同時に放電セルを形成する隔壁と、前記隔壁の側面及び前記アドレス電極上面に塗布された蛍光体と、前記前面基板上に前記アドレス電極と交差する方向のストライプ状でお互い一定の間隔で並んで形成された走査電極及び共通電極と、前記前面基板上に前記走査電極及び共通電極を覆うように積層された誘電体層とを具備したプラズマ表示パネルにおいて、前記誘電体層上に形成されたカーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層されたMgO層とを具備した2次電子増幅構造体を採用したことを特徴とする。

【0012】本発明において、前記MgO層の代りに、 MgF_2 、 CaF_2 、 LiF 、 Al_2O_3 、 ZnO 、 CaO 、 SrO 、 SiO_2 及び La_2O_3 中いずれか一つの物質よりなる層であっても良く、前記電極はCs、W、Mo、Ta、Fe、Cu中少なくともいずれか一つの金属で形成されていることが好ましい。3電極面放電型プラズマ表示パネルはまた、前記蛍光体と背面基板の電極との間にカーボンナノチューブを有する構成、および／ま

たは、前記蛍光体と前記MgO層との間の隔壁側面にカーボンナノチューブを有する構成である。

【0013】また、前記のような目的を達成するために、本発明に係る2次電子増幅構造体を採用したバックライトは、一定の間隔を隔ててお互い対向するように配置されて放電空間を形成する前面基板及び背面基板と、放電空間の前面基板の内側面上に形成された初期放電用第1電極と前記第1電極上に形成された蛍光体層と、放電空間の背面基板上に一定の間隔を隔ててお互いに並んだ方向に、ストライプ状に形成された放電維持用の第2電極および第3電極と、前記背面基板上に前記第2電極及び第3電極を覆うように塗布された誘電体層と、前記前面基板と背面基板を前記一定の間隔で維持しながら放電空間を密封する隔壁とを具備したバックライトにおいて、前記誘電体層上に形成されたカーボンナノチューブと、前記カーボンナノチューブ上に積層されたMgO層とを具備した2次電子増幅構造体を採用したことを特徴とする。

【0014】本発明において、前記MgO層の代りに、 MgF_2 、 CaF_2 、 LiF 、 Al_2O_3 、 ZnO 、 CaO 、 SrO 、 SiO_2 及び La_2O_3 中いずれか一つの物質よりなる層であっても良く、前記第2電極及び第3電極はCs、W、Mo、Ta、Fe、Cu中少なくともいずれか一つの金属で形成されていることが好ましい。前記蛍光体と第1電極との間にカーボンナノチューブがさらに形成した構成となっている。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明に係る2次電子増幅構造体、及び、これを採用したプラズマ表示パネルと液晶表示パネル用バックライトを詳細に説明する。本発明では前記のように提起された問題点を解決するために、まず、MgO層の長所をそのまま利用すると同時に、放電セル内で効率を極大化するためにMgO形成前にカーボンナノチューブ(carbon nanotube)を形成し、その上にMgO薄膜を積層した2次電子増幅構造体を提供することによって、放電空間内での電子放出が極大化されるようにする。また、本発明ではこのような2次電子増幅構造体を製作して保護膜、蛍光体、隔壁に挿入することによって電子放出を極大化させたプラズマ表示パネルと液晶表示パネル用バックライトを提供する。

【0016】図3は、本発明に係る2次電子増幅構造体の構成を示す断面図である。本発明に係る2次電子増幅構造体は、カーボンナノチューブ300とMgO層400で構成され、図面では2次電子放出効率を測定するためにガラス基板1000上に積層された電極2000上に積層した試料を示した。ここで、電極2000としてNi層2000を使用した、Ni層はガラス基板1000上に蒸着されずらいので、バッファ層としてCr層2100を蒸着した後、その上に蒸着し形成した。

【0017】ここで、MgO層400の代りにMgF₂、CaF₂、及びLiFのようなフッ化物や、Al₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂及びLa₂O₃のような酸化物を、カーボンナノチューブ300上に形成した2次電子増幅構造体としても、相当な2次電子増幅効果を得られる。また、このような物質を電子放出係数が大きい金属、即ちCs、W、Mo、Ta、Fe、Cuで形成された電極2000上に形成することが望ましい。

【0018】このようなカーボンナノチューブ300上にMgO層400を蒸着した2次電子増幅構造体の2次電子放出に対する実験結果は次の通りである。即ち、本実験では、以下に示すような、異なった層構成を持つ3種類の試料について、図4に示した装置で2次電子放出係数δを測定して比較した。(1) MgO層、(2) カーボンナノチューブ層、(3) 本発明に係るカーボンナ*

$$\delta = 1 - (I_t/I_p) = I_s/I_p, \quad I_p = I_t + I_s$$

【0021】本発明に係る2次電子増幅構造体を有する試料において、カーボンナノチューブ上にMgO層を蒸着させる際の、蒸着条件を、基板温度、蒸着率、酸素分圧、厚さなどを変化させて測定した。その結果、各々の因子の変化に応じて2次電子放出係数も変化することが分かった。そこで、これら因子を変化させ、2次電子放出係数δが一番大きくなる条件において、前記3種類の試料について2次電子放出係数δを測定し比較した。

【0022】＜実験例1＞図5は、1次電子のエネルギー変化に伴う2次電子放出係数δの変化を示すグラフである。図5に示したように、2次電子放出が最大になる時の、各試料の2次電子放出係数δは以下の通りであった。カーボンナノチューブ+MgO(図面ではMgO/カーボンナノチューブ)試料の場合、δ=2300、MgO層だけ形成された試料での場合、δ=5.55、カーボンナノチューブだけで形成された試料での場合、δ=2.46。結果的に、MgO/カーボンナノチューブ層構成を有する試料の場合が、2次電子放出係数δが一番大きいと確認された。このような2次電子増幅構造体は2次電子放出係数δが相対的に非常に大きいので、この構造を表示素子PDP、FED及び電子増幅器、光増幅器に用いると、著しい2次電子増幅効果を得られることが立証された。

【0023】図6は、本発明に係る2次電子増幅構造体の試料で1次電子エネルギーに従う2次電子放出係数δを比較したグラフである。具体的に、MgO/カーボンナノチューブ構造でMgO層の厚さを変えた時、2次電子放出係数δの変化を測定したグラフである。図5と図6に示されたように、本発明に係る2次電子増幅構造体を使えば、既存の方法のように増幅率を高めるのに数回の衝突を必要とせず、1、2回の増幅だけで希望の電子の増幅率を得られるようになる。即ち、2次電子増幅構

*ノチューブ+MgO層

【0019】2次電子放出係数測定装置は、真空チャンバ500、試料510に電子ビームを照射する電子銃520、試料510に電圧を印加する可変電源540及び試料510で流れる電流を測定するための電流計530より構成される。測定方法は次の通りである。まず、真空チャンバ500内に3つの試料510を装着し、可変電源540で試料510の電極に適当な電圧を印加した状態で電子銃520で試料510に電子ビームを照射すれば、電子ビームが試料510の表面に衝突して2次電子を放出する。この2次電子により形成される電流がI_sである。電子ビームがなす電流をI_pとすると、電流計530で測定される電流がI_tの場合、2次電子放出係数δについて、数式1のような関係が成立する。

【0020】

【数1】

造体で得られる信号利得は(即ち、増幅率は)、次の数式2で示される。

【0024】

【数2】

$$\text{Gain} = \delta_1 \delta^{(n-1)}$$

【0025】ここで、δ₁は初期衝突での増幅率(gain)で、δ⁽ⁿ⁻¹⁾は初期衝突でδ₁の増幅率を有する試料に数回順次に衝突された時の平均増幅率であり、nは電子がチャンネルの長さに従って衝突された回数を示す。即ち、数式2及び図5と図6から分かるように、本発明を用いると、従来法のように数回の増幅を必要とせず、1、2回の増幅だけで希望の増幅率を得ることができる。したがって、複雑なMCP、PMTの構造を簡単に作ることができ、大面積化も可能になる。従来、大画面において増幅率を上げることは、コストが高く、かつ、製作が難しいという短所があったが、本発明による物質を用いると、大画面が容易に製作できてコストダウン効果を奏することができる。

【0026】＜実験例2＞次に実験例1と同じ方式で製作された2次電子増幅構造体と、カーボンナノチューブを印刷法で形成した薄膜と、既存MgO層とに対してイオンによる2次電子放出係数γを測定した。このデータは、本発明の2次電子増幅構造体をPDPとPDP構造を用いたバックライト製作時に通常保護層として使われるMgOの代りに使用すると、高い2次電子放出係数γによって駆動電圧を下げられる可能性があるという根拠となる。

【0027】イオンによる2次電子放出係数γ値を測定した結果、実際のPDP内部でのイオンの加速電圧(50V以下)でイオンによる2次電子放出係数γが増大することを確認した。これは数式3で表示される。

【0028】

【数3】

$$V_f = \frac{A(pd)}{\ln \left[\frac{B(pd)}{\ln(1 + \frac{1}{\gamma})} \right]}$$

【0029】ここで、 V_f はPDPの初期放電電圧で、 γ は2次電子放出係数、 A 、 B はガスで決定される常数であり、 d は電極間の距離である。このような数式3に基づいてイオンによる2次電子放出係数 γ が大きくなるので駆動電圧の下がり期待できる。

【0030】図7はこのような測定結果を示すグラフであって、各々相異なる構成を持つ層の2次電子放出係数 γ を測定することによって、各々の違いを比較できる。グラフでMgO層はMgO層、カーボンナノチューブ層、カーボンナノチューブ+MgO 1 (MgO 2) はカーボンナノチューブ上にMgO層が形成された層(MgO 1とMgO 2は蒸着条件差)を各々示す。PDPのセル内で実際に測定される加速電圧は約30V以下であるので、2次電子放出係数 γ の値も30V以下の範囲で比較する。この比較により、従来のMgOよりもカーボンナノチューブ、カーボンナノチューブ+MgOの方が γ 値が大きいことが観察され、これはPDPとPDP構造を用いたバックライトランプ構造で駆動電圧が下がることを意味する。

【0031】以上のような実験は最初に進行された実験であって、カーボンナノチューブ上にMgO薄膜が形成されることによって2次電子放出係数が増大することを確認した。即ち、実験例1では、電子による2次電子放出係数(δ と表示)の増加を確認し、実験例2では、イオンによる2次電子放出係数(γ と表示)の増加を確認した。

【0032】まず、電子による2次電子放出係数値 δ は、既存のMgO層では、2～5程度であるに対して、本発明に係る2次電子増幅構造体では、19000まで増大した。すなわち、2次電子増幅構造体では電子による2次電子放出が今まで知られた物質(約80程度と知られている)より数百倍以上増大することを確認した。このような放出係数 δ の増加は、MgO表面の表面積が増大して大きくなったためであると考えられ、このMgOの表面積増加は、カーボンナノチューブによる増幅効果によることと思われる。

【0033】また、イオンによる2次電子放出係数 γ 値を測定した結果、2次電子放出係数 γ は実際のPDP内部で、イオンの加速電圧(50V以下)により、増大することを確認した。これは数式3で表示されているが、この数式3で示されたように、イオンによる2次電子放

出係数 γ の値が大きくなるほど、初期放電電圧 V_f の値は小さくなる結果を示す。

【0034】本発明により、カーボンナノチューブ上にMgO層を積層させた構成の方が、一般的な保護膜であってPDP放電空間に形成されるMgOよりも γ 値が大きくなり、PDP駆動電圧が下がることを確認できた(PDP放電時にイオンの加速電圧が50V以下)。このように γ 値が大きくなることは、現在PDP構造のLCDバックライトを使用する平板ランプでも本発明に係る2次電子増幅構造体を使えば、ランプの駆動電圧が下がるってLCD素子の駆動電圧を下げる効果を奏しうることを意味する。

【0035】また、前記のような2次電子増幅構造体を形成するには、MgO層の他にもMgF₂、CaF₂、及び、LiFのようなフッ化物やAl₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂及びLa₂O₃のような酸化物をカーボンナノチューブ上に積層しても、大きい2次電子増幅効果を得られることは前述したとおりである。これらの中で、SiO₂層をカーボンナノチューブ上に積層した2次電子増幅構造体での2次電子増幅効果を測定した結果のグラフが図8に示される。図に示したように、SiO₂層/カーボンナノチューブで構成された2次電子増幅構造体の試料では2次電子放出係数 δ が6000まで増加することが分かる。

【0036】このような結果により、電子とイオンによる2次電子放出係数が性能に重要な役割をする表示装置のFED、PDPに応用でき、MCP及びPMTに応用できる。従って従来よりも改善された駆動電圧を有するディスプレイ及び増幅器素子を製作できる。このような2次電子増幅構造体をプラズマ表示パネルに適用した本発明に係る実施例が図9に示される。

【0037】図9は、前記のような2次電子増幅効果を示す2次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネルの一実施例の垂直断面図である。図に示したように、本発明に係る2次電子増幅構造体を採用した3電極面放電型プラズマ表示パネルは、基本的に一定の間隔を隔ててお互い対向する前面ガラス基板200及び背面ガラス基板100と、空間を分割して各画素に対応する放電空間210を含むセルを構成する隔壁130と、各放電セル210で放電を起こすためのアドレス電極110及び走査電極140と共通電極150とを具備し、誘電体層180とMgO保護層190との間にカーボンナノチューブ220を蒸着した構造を有することが一番大きい特徴である。

【0038】即ち、MgO保護層190とカーボンナノチューブ220とより構成される2次電子増幅構造体を具備したことが一番大きい特徴である。ここで、保護層190の構成物質としてMgF₂、CaF₂、及び、LiFのようなフッ化物やAl₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂及びLa₂O₃のような酸化物を使用してカ

ーボンナノチューブと共に 2 次電子増幅構造体を形成しても、相当な 2 次電子増幅効果を得られる。また、このような物質を電子放出係数値が大きい金属、即ち Cs、W、Mo、Ta、Fe、Cu で形成された電極上に形成することが望ましい。

【0039】このような 2 次電子増幅構造体は、同一平面にアドレス電極 110 と交差する方向に並んで配置された、走査電極 140 と共通電極 150 との間に印加された電圧により、放電空間 210 に面放電が起きれば 2 次電子を大量で放出する。これは即ち、走査電極 140 と共通電極 150 との間に印加された電圧により、不活性ガスによる大量のプラズマ放電状態が形成されることを意味する。この際、既存の PDP よりも多量の不活性ガスがイオン化され、より多量の紫外線が放出され、蛍光体 170 を励起して画像の輝度を画期的に高められるようになる。ここで、部材番号 120 は誘電体層である。

【0040】また、図 10 は、本発明に係る 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネルの他の実施例を示す断面図である。この実施例の構造は、図 9 の実施例と同じ構造で蛍光体 170 と MgO 保護層 190 との間の隔壁側面上にカーボンナノチューブ 240 を蒸着したり、蛍光体 170 と電極 110 (あるいは誘電体 120) との間にカーボンナノチューブ 230 を形成して 2 次電子放出の効果を極大化したものである。

【0041】一方、図 11 は、本発明に係る 2 次電子増幅構造体を採用した液晶表示素子用バックライトの概略的構成を示す垂直断面図である。図に示したように、この実施例は、前述した 2 次電子増幅構造体を採用した 3 電極面放電型プラズマ表示パネルと類似の構造を有する。即ち、この実施例は、基本的に一定の間隔を隔ててお互い対向する前面ガラス基板 60、及び、背面ガラス基板 50 間に放電空間 59 を形成し、放電空間 59 を隔壁 56 で密封する。このように形成された放電空間 59 で、初期放電を起こすための(壁電荷形成のための)第 1 電極 57 を前面ガラス基板 60 の内側面上に形成し、その上に蛍光体層 58 を形成する。

【0042】このような放電空間 59 内の壁電荷を用いて、放電を維持し続けるための面放電を起こすが、この面放電を遂行するための第 2 電極 51 と第 3 電極 52 が、背面ガラス基板 50 上に一定の間隔を隔てて並んで形成される。これら第 2 電極 51 及び第 3 電極 52 が覆われるように背面基板 50 上には誘電体層 53 が塗布される。この誘電体層 53 上にカーボンナノチューブ 54 と MgO 保護層 55 が積層されて形成された 2 次電子増幅構造体が形成されたことが特徴である。

【0043】即ち、カーボンナノチューブ 54 と MgO 保護層 55 とより構成される 2 次電子増幅構造体を具備して、2 次電子の増幅効果を高めたことが、一番大きい特徴である。ここで、MgO 保護層 55 の代りに、Mg

F₂、CaF₂、及び、LiF のようなフッ化物や、Al₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂ 及び La₂O₃ のような酸化物を、カーボンナノチューブ 54 上に蒸着して 2 次電子増幅構造体を形成しても、相当な 2 次電子増幅効果を得られる。また、このような物質を電子放出係数値が大きい金属、即ち Cs、W、Mo、Ta、Fe、Cu で形成された電極上に形成することが望ましい。

【0044】また、図 12 は、図 11 に示したようなバックライトにおいて、第 1 電極 57 と蛍光体層 58 との間に、カーボンナノチューブ 61 を設けた構成であり、このような構成とすることも望ましい。このようにすれば、バックライトの輝度がさらに向上する。このような輝度向上は、蛍光体の表面積が広がって輝度が向上することと考えられる。

【0045】

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る 2 次電子増幅構造体は、カーボンナノチューブ上に MgO 薄膜や MgF₂、CaF₂、及び、LiF のようなフッ化物や Al₂O₃、ZnO、CaO、SrO、SiO₂ 及び La₂O₃ のような酸化物薄膜を積層した構造で製作されて、電子やイオンによる 2 次電子放出係数を増大させる作用をする。従って、このような 2 次電子増幅構造体を使用すれば、次のような効果を得られる。

【0046】1. PDP に適用すれば、PDP 内部でのイオンによる 2 次電子放出係数 γ が増大するので高い輝度を得られる。これは PDP を駆動させる駆動電圧を下げられることを意味し、合わせて PDP 回路の安定化にも寄与しコストをやすくできる長所を付与する。2. PDP 構造を LCD バックライトに適用する場合には、LCD バックライトの輝度を高める。従って、これはバックライトの駆動電圧を下げられることを意味する。

【0047】3. FED と FED 構造を用いた LCD バックライト、マイクロチャンネルプレート(MCP)、光増配チューブ(PMT)に適用すれば、PDP と同じように 2 次電子放出係数 δ が増大する。従って、このような素子のセル内部にカーボンナノチューブあるいはカーボンナノチューブ+MgO が挿入されれば輝度向上(駆動電圧の下がり)を図りうる。また、本発明を利用すると増幅率が高くなるので、既存増幅器の厚さ及び直径、構造変換が自在である。さらに、MCP を用いた他のデバイスにも応用が可能であり、他のデバイスの性能改善効果を奏しうる。即ち、結果的に各デバイスの性能改善(駆動電圧の立ち下がり及び輝度増大)とデバイスのコストダウン及び収率が向上する効果を奏しうる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】既存 3 電極面放電型プラズマ表示パネルの概略的構成を示す斜視図。

【図 2】図 2A 及び図 2B は、図 1 のプラズマ表示パネルを横方向及び縦方向に切開した断面図。

【図 3】本発明に係る 2 次電子増幅構造体の実施例を示す断面図。

【図 4】2 次電子放出係数を測定する装置を概略的に示す図面。

【図 5】カーボンナノチューブ+MgO で形成された図 3 の 2 次電子増幅構造体試料で電子による 2 次電子放出係数を測定して示したグラフ。

【図 6】本発明に係る 2 次電子増幅構造体で MgO の蒸着厚さに従う 2 次電子放出係数を比較して示したグラフ。

【図 7】カーボンナノチューブ+MgO で形成された図 3 の 2 次電子増幅構造体試料でイオンによる 2 次電子放出係数を測定して示したグラフ。

【図 8】カーボンナノチューブ+SiO₂ で形成された図 3 の 2 次電子増幅構造体試料で電子による 2 次電子放出係数を測定して示したグラフ。

【図 9】本発明に係る 2 次電子増幅構造体を採用したプ*

* ラズマ表示パネルの一実施例の概略的構成を示す垂直断面図。

【図 10】本発明に係る 2 次電子増幅構造体を採用したプラズマ表示パネルの他の実施例の概略的構成を示す垂直断面図。

【図 11】本発明に係る 2 次電子増幅構造体を採用した液晶表示パネル用バックライトの一実施例の概略的構成を示す垂直断面図。

【図 12】本発明に係る 2 次電子増幅構造体を採用した液晶表示パネル用バックライトの他の実施例の概略的構成を示す垂直断面図である。

【符号の説明】

300……カーボンナノチューブ

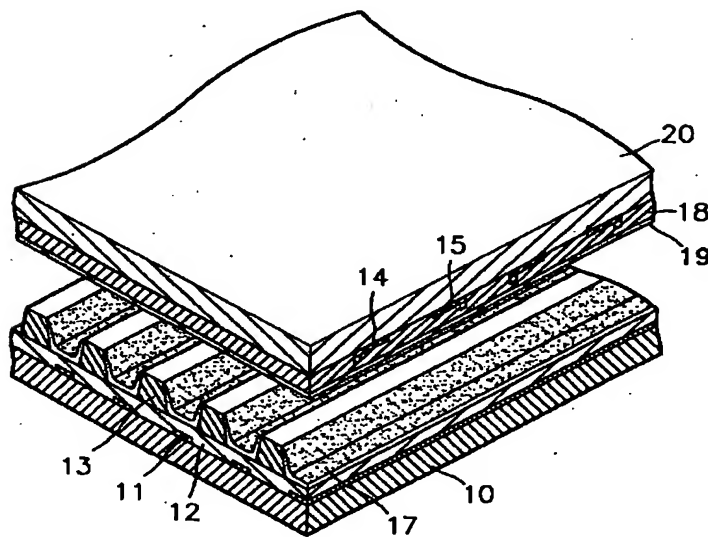
400……MgO 層

1000…ガラス基板

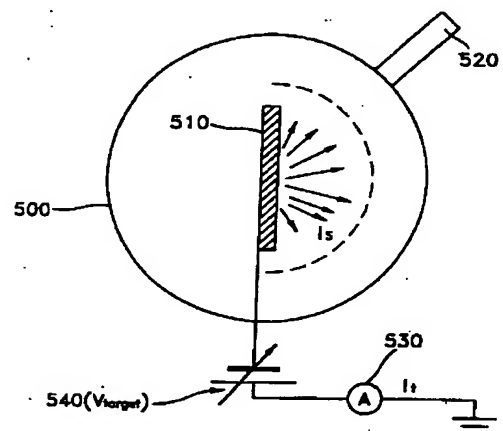
2000…電極

2100…Cr 層

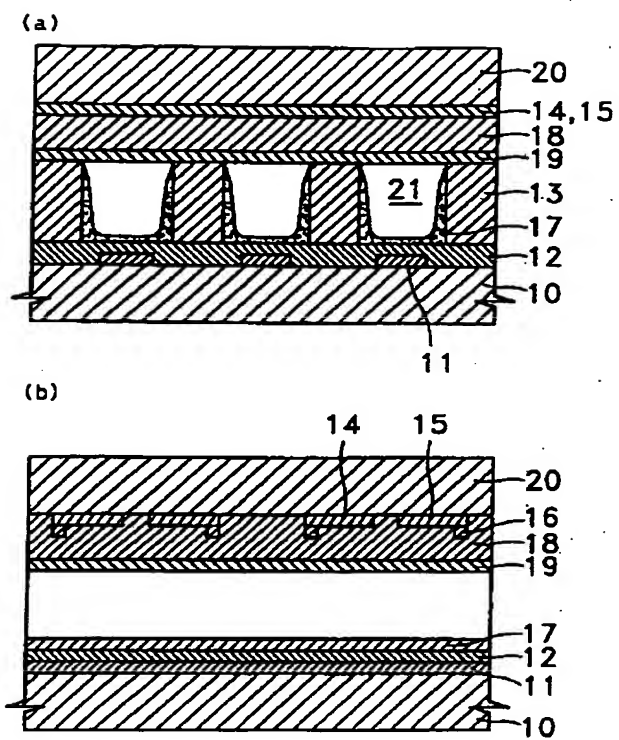
【図 1】



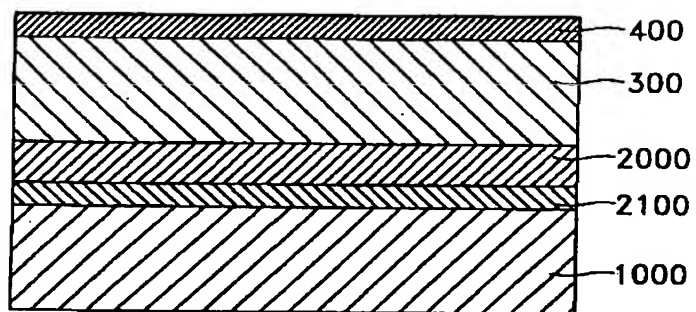
【図 4】



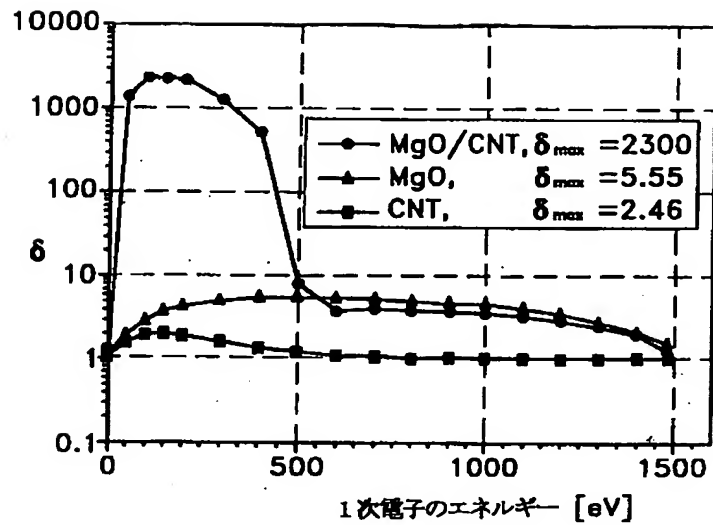
【図 2】



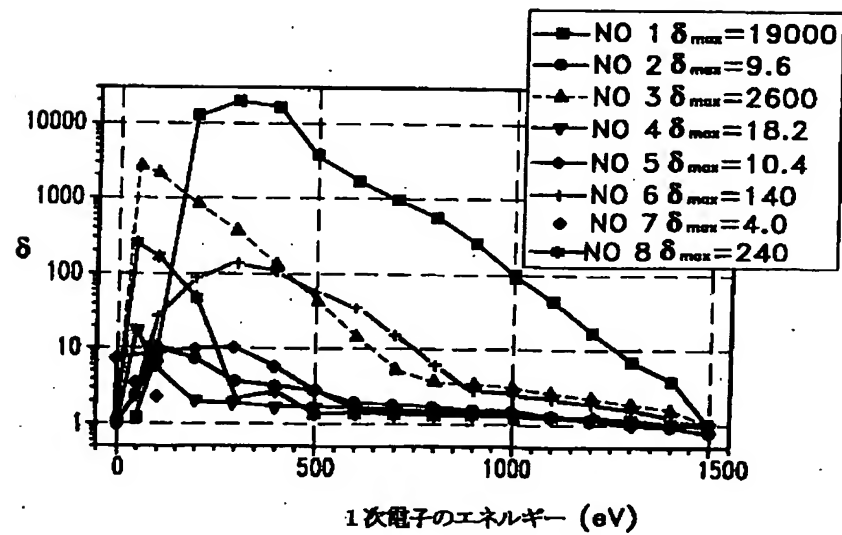
【図 3】



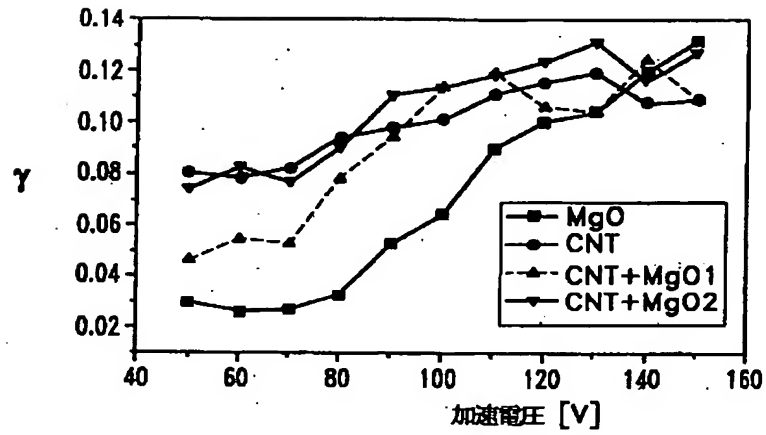
【図5】



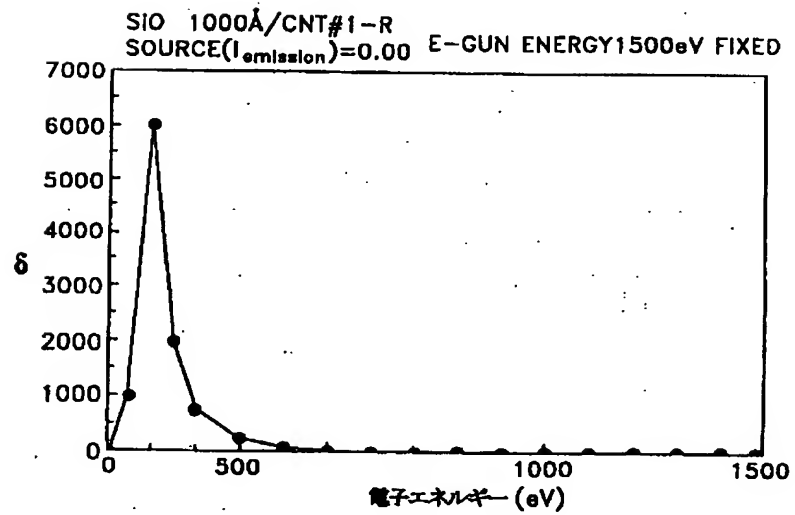
【図6】



【図7】



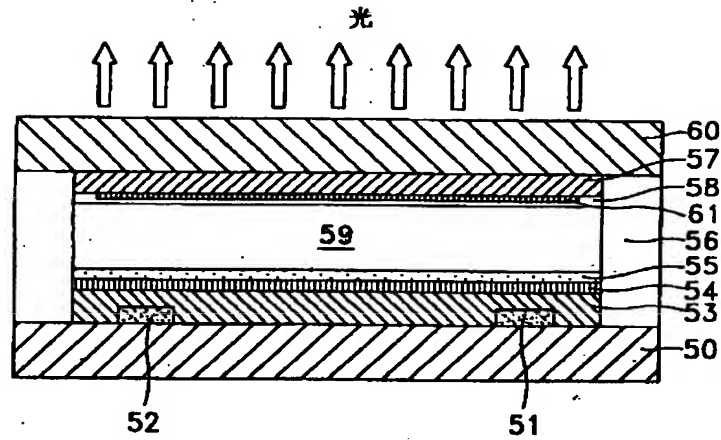
【図8】



A cross-sectional view of a substrate assembly. The assembly consists of several layers: a bottom layer (100), a layer (110), a layer (120), a layer (130), a layer (170), a layer (190), a layer (220), a layer (180), a layer (140), and a top layer (200). A patterned layer (210) is formed on the surface of layer 170, featuring a series of rectangular openings. Arrows indicate the direction of light or signal passing through the openings in layer 210.

A cross-sectional view of a semiconductor device 150. The device consists of a substrate 100 with a series of vertical channels 110. A layer 120 is formed on the substrate, and a layer 130 is formed on top of layer 120. A layer 170 is formed on top of layer 130, and a layer 190 is formed on top of layer 170. A layer 220 is formed on top of layer 190, and a layer 180 is formed on top of layer 220. A layer 140 is formed on top of layer 180, and a layer 200 is formed on top of layer 140. A layer 210 is formed on top of layer 190, and a layer 230 is formed on top of layer 210. A layer 240 is formed on top of layer 230. The device 150 is shown in a cross-sectional view.

【図 12】



フロントページの続き

(72)発明者 韓 仁澤
大韓民国 京畿道 龍仁市 器興邑 農書
里 山14-1番地 三星綜合技術院内
(72)発明者 李 晶姫
大韓民国 京畿道 龍仁市 器興邑 農書
里 山14-1番地 三星綜合技術院内

(72)発明者 俞 世起
大韓民国 京畿道 龍仁市 器興邑 農書
里 山14-1番地 三星綜合技術院内
Fターム(参考) 5C040 FA01 GE08 GF02 GG05 JA07
MA03 MA12